



匯 寶 國 際 股 份 有 限 公 司

RICH-BRIGHT GLOBAL COMPANY LIMITED

臺 灣 省 臺 中 市 美 村 路 二 段 9 7 巷 4 號

廣 東 省 東 莞 市 南 城 區 鴻 福 路 108 號 中 盛 商 務 大 廈 311 室

# Low Voltage MOSFET

item	RB Device Name	Type	BV(V)	VGS & VF(V)	Vt MAX(V)	Ron_10V_Max(Typ)mΩ	Ron_4.5 V_Max(Typ)mΩ	Ron_2.5 V_Max(Typ)mΩ	Ron_1.8 V_Max(Typ)mΩ	Ciss (pF)	Coss (pF)	Crss (pF)	Qg_4.5V (nC) Typ	Qgs (nC)	Qgd (nC)	ESD Cell	Package Type
14	RB1557CYD	NMOS	30	±20	2.5	22(17)	39(30)	--	--	370	68	40	7.2	1.5	1.7	No	PDFN3*3-8L
15	RB20T03CWT	NMOS	30	±20	3	50(40)	80(65)	--	--	270	70	50	4	1.6	2.4	No	TO-252-3L
16	RB2F30CNW	NMOS	30	±12	1	16(14)	18(16)	30(25)	--	720	81	40	7.5	3.2	3.2	No	DFN2×2-6L
17	RB2306CWP	NMOS	30	±20	3	30(23)	40(30)	--	--	566	118	60	4.2	1.8	1.35	No	SOT-23
18	RB3009CAD	NMOS	30	±20	2	7(6)	11(9)	--	--	1200	125	50	31	18	9.7	No	PDFN3*3
19	RB3009CJO	NMOS	30	±20	2	7(6)	11(9)	--	--	1200	920	50	31	18	9.7	No	DFN3*3-8L
20	RB3013CJU-D	Dual NMOS	30	±20	2.1	15(11)	19(15)	--	--	1650	200	35	35	5.5	8.2	No	SOP-8L
21	RB3015CJD-D	Complementary N+P	30	±20	2.5	15(12.6)	22(16)			560	71	55	64	11	25	No	PDFN3*3
22	RB3404CWP	NMOS	30	±20	3	30(22)	43(30)	--	--	480	102	72	4	1.2	1.7	No	SOT-23
23	RB3406CWP	NMOS	30	±20	3	40(35)	65(45)	--	--	410	80	65	11	1.6	2.8	No	SOT-23
24	RB3412CYW	NMOS	30	±12	1.5	25(17)	28(25)	50(36)		720	81	40	7.5	3.2	3.2	No	DFN2×2-6L
25	RB4416CWU	Dual NMOS	30	±20	3	15(12)	24(16)	--	--	920	160	83.2	7.7	1.6	3.1	No	SOP-8L
26	RB4542CUU	Complementary N+P	30	±20	3	30(21)	40(34)	--	--	407	113	57	--	--	--	No	SOP-8L
27	RB4936CWU	Dual NMOS	30	±20	3	28(22)	38(30)	--	--	620	102	77	13	4.2	3.1	No	SOP-8L



匯 寶 國 際 股 份 有 限 公 司

RICH-BRIGHT GLOBAL COMPANY LIMITED

臺 灣 省 臺 中 市 美 村 路 二 段 9 7 巷 4 號

廣 東 省 東 莞 市 南 城 區 鴻 福 路 108 號 中 盛 商 務 大 廈 311 室

# SGT MOSFET

item	RB Device Name	Type	BV(V)	VGS & VF(V)	Vt MAX(V)	Ron_10V_Max (Typ)mΩ	Ron_4.5 V_Max(Typ)mΩ	Ron_2.5 V_Max(Typ)mΩ	Ciss (pF)	Coss (pF)	Crss (pF)	Qg_4.5V (nC) Typ	Qgs (nC)	Qgd (nC)	ESD Cell	Package Type
2	RB3002NMT	NMOS	30	±20	2.2	1.1(0.8)	1.7(1.3)	--	3600	800	65	84	16	10	No	T0-252
8	RB4503LMT	NMOS	40	±20	2.2	3(2.3)	4.5(3.5)	--	1400	300	50	84	16	10	No	T0-252
18	RB7009NMT	NMOS	70	±20	3	7(6)	8.5(7)	--	1310	520	22	24	6.1	7.2	No	T0-252
19	RB8006NMT	NMOS	70	±20	2.5	9.5(7.4)	15(10)	--	1297	473	23	23	5.2	7.3	No	T0-252
24	RB8802NMT	NMOS	75	±20	4	6.5(5.7)	--	--	1430	230	63	23	5.2	7.3	No	T0-252
27	RB8802NMT	NMOS	75	±20	4	6.5(5.7)	--	--	1430	230	63	23	5.2	7.3	No	T0-252
48	RBA007NMT	NMOS	100	±20	3	6.2(5.5)	9(8)	--	2100	405	32	57.3	13	12.1	No	T0-252
57	RBA009NMT	NMOS	100	±20	3.5	9.5(8.3)	17(12)	--	1850	820	50	64	17	10	No	T0-252



匯 寶 國 際 股 份 有 限 公 司

RICH-BRIGHT GLOBAL COMPANY LIMITED

臺 灣 省 臺 中 市 美 村 路 二 段 9 7 巷 4 號

廣 東 省 東 莞 市 南 城 區 鴻 福 路 108 號 中 盛 商 務 大 廈 311 室

# SJ MOSFET

Item	RB Device Name	Type	BV(V)	VGS & VF(V)	Vt MAX(V)	Ron_10V_Max (Typ)mΩ	Ron_4.5V_Max(Typ)mΩ	Ciss (pF)	Coss (pF)	Crss (pF)	Qg_4.5 V (nC) Typ	Qgs (nC)	Qgd (nC)	ESD Cell	Package Type
13	RB65R35LPA	NMOS	650	±30	4.2	335 (310)	350 (320)	820	75	3.5	17	5	5.3	No	T0-220F
14	RB70R35LPA	NMOS	700	±30	4.2	335 (310)	350 (320)	820	75	3.5	17	5	5.3	No	T0-220F
15	RB65R35LST	NMOS	650	±30	4.2	335 (310)	350 (320)	820	75	3.5	17	5	5.3	No	T0-252
16	RB70R35LST	NMOS	700	±30	4.2	335 (310)	350 (320)	820	75	3.5	17	5	5.3	No	T0-252
17	RB65R35FPK	NMOS	650	±30	4.2	335 (310)	350 (320)	820	75	3.5	17	5	5.3	No	DFN5*6-8L
18	RB70R35FPK	NMOS	700	±30	4.2	335 (310)	350 (320)	820	75	3.5	17	5	5.3	No	DFN5*6-8L
19	RB65R35CPB	NMOS	650	±30	4.2	335 (310)	350 (320)	820	75	3.5	17	5	5.3	No	DFN8*8
20	RB70R35CPB	NMOS	700	±30	4.2	335 (310)	350 (320)	820	75	3.5	17	5	5.3	No	DFN8*8
21	RB65R35LPA	NMOS	650	±30	4.2	335 (310)	350 (320)	820	75	3.5	17	5	5.3	No	T0-220F
22	RB70R35LPA	NMOS	700	±30	4.2	335 (310)	350 (320)	820	75	3.5	17	5	5.3	No	T0-220F
23	RB80R380LPA	NMOS	800	±30	4	440(380)		1300	950	50	38	7.3	15	No	T0-220F
24	RB65R09LPA	NMOS	650	±30	4.2	115(90)		2800	205	21	28	5.8	17	No	T0-220F
25	RB65R07LPX	NMOS	650	±30	4	70(63)		4400	1960	160	130	30	58	No	T0-247